

Customer:	ALPS EUROPE Distribution	No: DMT-06-085
Attention:		Date: 29.06.06
Your ref.:		
Your part No.:	SKHHLSA010	

SPECIFICATION

PURPOSE OF THIS DOCUMENT:	ALPS:	
[] Preliminary copy.	Model:	TACT SWITCH
[X] Request for your Approval.		SKHHLSA010
([X]New []Engineering Change)	Spec. No:	KHH-711
Please sign and return one copy.	Sample No	_
APPROVED BY Date:		
X		
Name		
Title		
[] For Production		
REMARKS:		
		01/

Designed: T. Kato Approved

ENG. DEPT. DORTMUND FACTORY

 $WERK\ DORTMUND \cdot GISELHERSTRASSE\ 4 \cdot 44319\ DORTMUND \cdot TELEFON\ 02\ 31/21\ 88-0 \cdot FAX\ 02\ 31/21\ 88-199 \cdot e-mail:\ alps-dortmund@alps-europe.com$

Amtsgericht Düsseldorf HRB 14717

DOC	UMENT No.	TITLE'	PRODUCT SPECIFIC	ATIONS		PAGE
	KHH711		、製品(L 様 書		1/6
BAC	KGROUND		·		,	
1			:			
1. G	eneral 一般事項					
1.1	Application 適用範	囲 This specificati	ion is applied to TACT switches which	h have no keytop.		
			は、キートップなしのタクトスイッチについて 適減			
1.2	Operating temperature ra	inge 使用温度範囲:		umidity,normal air pressure	常湿·常圧)	·
1	Storage temperature rang				Υ	
1.4	Test conditions 試験状態		se specified, the atmospheric condition		s and tests are as follows.	
			定は特に規定がない限り以下の標準状 mperature 常 温:(Temperatu			
		Normal te		ure 温度 5~35℃) umidity 湿度 25~85%)		
				re 気圧 86~106kPa)		
			t arise from judgement, tests shall be		conditions.	
		ただし、判定	に疑義を生じた場合は以下の基準状態	で行う。		
	•		emperature 温 度: 20±2℃			,
		Relative h				
		Air pressu	ure 気 Æ: 86~106kPa			
2. Ar	pearance, style and dime	nsions 外観、形状、	寸法			
	Appearance 外観		There shall be no defects that	affect the serviceability of t	the product.	
			性能上有害な欠陥があってはな	らない。		
2.2	Style and dimensions #8	状、寸法 Refer	r to the assembly drawings. 製品図[こよる。		
		.	n			
3. Ty	pe of actuating 動作形:	式 <u>Tactile fee</u>	edback タクティールフィードバック			
4. Cr	ontact arrangement 回路	形式 1 noles				
" -			of contact arrangement are given in	the assembly drawings 🗓	路の詳細は製品図による)	
	itings 定格 Maximum ratings 最大定	tk 12 V	DC			
	Minimum ratings 最小定		DC <u>50 m</u> A DC 10 \(\mu \) A			•
-		. .	<u></u>		v	
6. Ete	ectrical specification 電気	式的性能			•	
l						
	Name TE F		T	· 久 //	0.44	如
6.1	Items 項目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		条件	Criteria	判定基準
6.1	Contact resistance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Test conditions		Criteria 100 mΩ Max.	判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below statemade.				判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below stat made. スイッチ操作部中央に下 (1)Depression	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N	neasurements shall be		判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below stat made. スイッチ操作部中央に下 (1)Depression	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co	neasurements shall be		判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below stat made. スイッチ操作部中央に下 (1)Depression	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co or voltage drop meti	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA.	<u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below stat made. スイッチ操作部中央に下 (1)Depression	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co or voltage drop meti 「kHz微少電流接触된	neasurements shall be	<u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイッチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co or voltage drop mett lkHz微少電流接触抵 法	neasurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDCSV 10mA電圧隊	<u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイッチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co or voltage drop met IkHz微少電流接触抵 法	neasurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDCSV 10mA電圧隊	<u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Gontact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイッチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10 N</u> od 測定方法: (kHz small-current co or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 per made following the test set forth oた後、測定する。	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計,又はDCSV 10mA電圧向 below:	_ <u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイッチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法:(kHz small-current co or voltage drop met IkHz微少電流接触抵 法	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計,又はDCSV 10mA電圧向 below:	<u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Gontact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10 N</u> od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti IkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>100 V DC for 1 m</u> 印加場所: Between all terminals.	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計,又はDCSV 10mA電圧向 below:	_ <u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Gontact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop met lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所: Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム	measurements shall be protect resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal	_ <u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Gontact resistance 接触抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA配圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame)	_ <u>100 m</u> Ω Max.	判定基準
	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイクチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth わた後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と	_ <u>100 m</u> Ω Max.	
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. Xイケ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring methol Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop met lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth った後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 pe made following the test set forth った後、測定する。	measurements shall be pontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) かある場合は、端子と below:	_100 mΩ Max. 拿下 _100 MΩ Min.	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイクチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (ktiz small-current or or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所: Between all terminals. frame, between term 蜡子間、金属フレーム 金属フレーム間 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60H	measurements shall be pontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) かある場合は、端子と below:	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: 5.10 N od 測定方法: (kHz small-current co or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth かた後、測定する。 印加電圧: 100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 蜡子間、金属フレーム 金属フレーム間 pe made following the test set forth かた後、測定する。 印加電圧: 250 V AC (50~60H 印加時間: 1 min	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計,又はDCSV 10mA電圧原 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) いがある場合は、端子と below:	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイクチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: <u>5.10</u> N od 測定方法: (ktiz small-current or or voltage drop meti lkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 m 印加場所: Between all terminals. frame, between term 蜡子間、金属フレーム 金属フレーム間 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60H	measurements shall be ontact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDCSV 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) いがある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: 5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or voltage drop meti IkHz微少電流接触抵法 be made following the test set forth かた後、測定する。 印加電圧: 100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム間 be made following the test set forth かた後、測定する。 印加電圧: 250 V AC (50~60H 印加場所:Between all terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の静荷重を加え、測定する。 押圧力: 5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti IkHz微少電流接触抵 法 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: 100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 場子間、金属フレーム 金属フレーム間 pe made following the test set forth oた後、測定する。 印加電圧: 250 V AC (50~60H 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals.	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	oreakdown.
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	r. 2 , ≥0€ 6
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	Max	r. 2 , ≥0€ 6
6.2	Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶線抵抗	Applying a below star made. スイチ操作部中央に下 (1) Depression (2) Measuring metho Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Applied position Measurements shall b 下記条件で試験を行っ (1) Test voltage (2) Duration	tic load to the center of the stem, r 記の幹荷重を加え、測定する。 押圧力: _5.10 N od 測定方法: (kHz small-current or or voltage drop meti (kHz微少電流接触抵法) be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _100 V DC for 1 m 印加場所:Between all terminals. frame, between term 端子間、金属フレーム 金属フレーム間 be made following the test set forth of 後、測定する。 印加電圧: _250 V AC (50~60H 印加時間: I min 印加場所:Between all terminals. A frame, between terminals. A	measurements shall be protact resistance meter nod at 5VDC 10mA. 抗計、又はDC5V 10mA電圧隊 below: in. And if there is a metal inals and ground(frame) がある場合は、端子と below: z) nd if there is a metal s and ground(frame)	100 mΩ Max. 100 mΩ Min. There shall be no be 絶縁破壊のないこと。	oreakdown.

APPD.

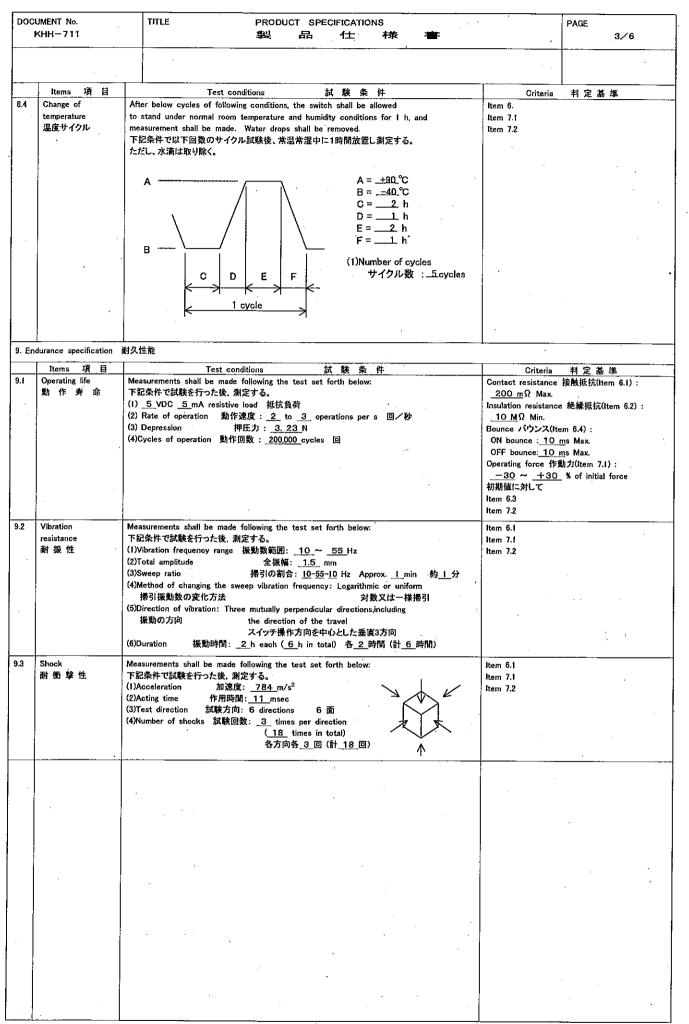
DSGD

DATE

APPD

CHKO

DOG	CUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
KHH-711		製品仕様書		2/6
	•			
<u> </u>	·			
<u></u>	Îtems 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use	ON bounce : 5 ms	Max.
	バウンス	(3 to 4 operations per s), bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	OFF bounce: 5 ms	Max.
		スイッテ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及び OFF時のパウンスを測定する。		
1		OTT MINOR TO SERVICE TO SE		
İ		Switch		
		Scilloscop		
		−		
		"ON" [[["OFF"	-	
				•
İ				
				•
		,		
7. M	echanical specification	機械的性能		
<u> </u>	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	柳 宁 甘 维
7.1	Operating force	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	_2. 55 ± 0.69 N	判定基準
	作動力	then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the		
		maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured.	1	
	Ì	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加える。		
	·	加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。		
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	0.25 + 0.2 /-	0.1 mm
	移動量	then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重		
		を加え、操作部が停止するまでの距離を測定する。		
ŀ		(I) Depression 押圧力: <u>5. 10 N</u>		
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is	0.49 N Min.	·
	復 帰 力	vertical and upon depression of the stem in its center the travel distance, the		•
		force of the stem to return tot its free position shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、		
		操作部が復帰する力を測定する。	J	
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	There shall be no s	
	ストッパー強度 	then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の	mechanically and el	•
		静荷重を加える。	機械的, 電気的に異	吊りないこと。
		(I) Depression 押圧力: 29.4 N		
		(2) Time 時間: <u>60</u> s		•
7.5	Stem strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	29.4 N	
	ステム抜去強度	then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of		
		stem operation shall be measured.		
	, .	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向 に操作部を引っ張って抜けない力である。		
		•		
	<u> </u>			
8. En	vironmental specification	n 耐候性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.	
	temperatures	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1	
	耐寒性	次の試験後, 常温, 常浸中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: -40 ± 2 ℃	Item 7.2	
		(1)Temperature 温 度: <u>~40 ± 2.</u> ℃ (2)Time 時 間: 96 h		
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。		
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.	
	耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1	
		次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2	
		(1) Temperature 温 度: <u>90 ± 2 °</u> C		
		(2) Time 時 間: <u>96</u> h		
8.3	Moisture .	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Contact resistance	接触抵抗(Item 6.1):
	resistance	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	200 mΩ Max.	
	耐湿性	次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	1 -	絶縁抵抗(Item 6.2):
ĺ		(1) Temperature 温度: <u>60 ± 2 °</u> C	_10_MΩ Min.	
		(2) Time 時 間: <u>96 h</u> (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90 ~ 95</u> %	Item 6.3 Item 6.4	
ļ		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1	
l	•		1. 20	



DOCUMENT No. KHH711		TITLE PRODUCT SPE 製 品	ECIFICATIONS					
0. 8	Soldering conditions #			<u> </u>				
	Items 項 目	B	\$46 \frac{1}{100} Are 164.					
0.1	Hand soldering	Please practice according to below conditions.	ed conditions 推 奨 条 件					
	手 半 田	以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: 3! (2)Continuous soldering time 連続半田時間: 3 (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 60 (4)Excessive pressure shall not be applied to the tu 端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux pener スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして	s Max. W Max. erminal tration from its top side.					
		In case an automatic flow soldering apparatus is us 噴流式自動半田装置で、半田付けされる場合は、次の	sed for soldering, adhere to the following conditions: 条件に従って下さい。					
	オートディップ半田	Items 項目	Soldering conditions 半田付け	条件				
	. '	(1)Preheat temperature プリヒート温度	110 °C Max. (Ambient temperature of printed circuit board on solds (プリント基板の半田付け面の周囲の温度)	ering side)				
		(2)Preheat time ブリヒート時間	_60 s Max.	····				
		(3)Flux foaming フラックス発泡量	To such an extend that flux will be kept flush with the board's top surface on which components are mounted applied to that side of printed circuit board on which to the area where terminals are located. プリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲から上が基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックス	d. Preparatory flux must not b components are mounted and らない程度にする。なお、プリン				
		(4)Soldering temperature 半田温度	_260 ℃ Max.	,				
		(5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間	5 s Max.					
		(6)Allowable frequency of soldering process 半田回数						
		(7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板 (8)Recommended flux	Printed circuit board shall be paper phenol with single design a through-hole at and/or near the switch mour circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。ストないでください。基板板厚は製品図に記載しています。 Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN)	iting area. Thickness of print イッチ周辺にスルーホールを設				
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8"相当(20°C換算でフラックス比重0.81以上)					
		(9)Other precaution その他注意事項	Safeguard the switch assembly against flux penetration スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい					
ļ			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
ĺ	,							
		,	•					
	•							
				•				
	•							
	· .							
			•					
	·	•						
		<u>.</u>	-					
	ļ			•				
	ĺ			-				
		-						

DOCUMENT No. KHH-711	TITLE	PRODUCT 製	IFICATION 仕	様	*		,	PAGE	5/6
				·			,		

【Precaution in use】ご使用上の注意

頂けるようにお願い致します。

A. General 一般項目

Al. This product has been designed and manufacturid for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, Information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L))、容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- BI. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. If soldering is made under the temperature or duration exceeding our recommend condition, molded plastic body may be melt. We highly recommend that soldering should be made under our recommended temperature conditions.

 弊社推奨半田付け条件を越えた条件で半田付けされますとスイッチ樹脂部の溶けが発生する可能性があります。半田付けは弊社推奨条件範囲内で実施して
- B3. If you use a through-hole PCB or a PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress.
 - スルーホールのプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付条件については事前に 十分な確認をして下さい。
- B4. If you use a PCB with smaller thickness than recommended, please pay enough attention to rising of switches when mounted. 推奨板厚より薄い基板をご使用の際は、実装時のスイッチ浮きに十分ご注意下さい。
- B5. When the switch is mounted on a printed circuit board, the case shall be held. And insert the product body to the specified fixing plane and fix it giving it the horizontal position. If it isn't fixed horizontally, it may cause maifunction.

 本スイッチをプリント基板へ取り付ける場合は、ケースを持って行って下さい。製品本体を規定の取付面まで挿入して水平になるように取り付けてください。水平にならないまま取り付けますと、動作不良の要因となります。
- B6. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B7. Do not press the stem but the switch body when you correct rising of the switch mounted on PCB. 基板実装後スイッチの浮きを修正する際は、スイッチのステムを押さずにスイッチ本体を押す様にして下さい。
- B8.Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes. スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160°C以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

B9.Take most care not to let flux foam penetrate the switch when you perform auto-dip soldering, which may sometimes produce too much foam. Take special care when you have LED or grounded terminals. オートディップの場合フラックスの発泡量過多によりフラックスがスイッチ内部に浸入する場合が有りますので十分にご注意ください。 (LED付・アース端子付の場合は特にご注意下さい)

- C. Washing process 洗浄工程
- CI. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D3. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.
 - ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D4. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D5. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

 スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。
 (ストッパー強度参照)

DOCUMENT No. KHH-711	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書					PAGE	PAGE 6/6	

- E. Using environment 使用環境
- El. Foreign matter invaded from outside. 外部侵入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

①Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙、発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

②Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

When you need higher dust-proof, make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.

より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。 `Dusty environment 塵埃環境



"→"Indicates the route of invasion.

"→"は侵入経路を示します。

- E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.
 - 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。
- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts,rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
 - 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤清剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。 •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular
 - siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
 シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
 - ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.
 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- GI. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.

電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。

- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては頻焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

